

2SA768, 2SA769

■シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ

☆ 2SC1826～2SC1827とコンプリメンタリペアになります。

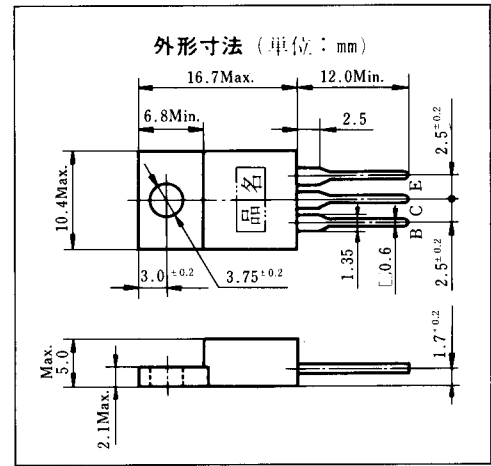
☆ レジンモールドケース

○ 一般用

○ 通信産業用

■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SA768	2SA769
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-60V	-80V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	-60V	-80V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	-6V	
コレクタ電流	I _C	-4A	
ベース電流	I _B	-1A	
許容コレクタ損失	P _C	30W (フランジ温度25°C)	
接合部温度	T _j	150°C	
保存温度	T _{stg}	-55～+150°C	



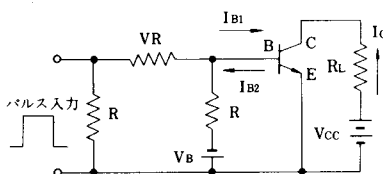
■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SA768	2SA769
最大コレクタシャ断電流	I _{CB0}		-1.0mA	-1.0mA
		V _{CB} =	-60V	-80V
最大エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -6V	-1.0mA	
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = -25mA	-60V	-80V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = -4V I _C = -1A	40 Min.	
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -2A I _B = -0.2A	-1.0V Max.	
シャ断周波数	f _T	V _{CE} = -10V I _E = 0.2A	10MHz Typ.	

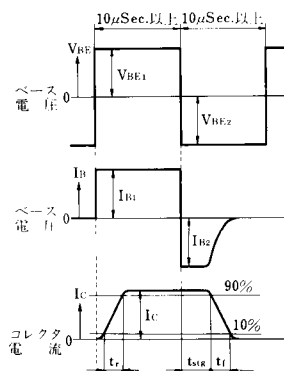
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
-6	3	-2	-300	300	1.0	0.4	0.15

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

